



0910 – 150M

150 Watts - 48 Volts, 150 μ s, 5%
Radar 890 - 1000 MHz

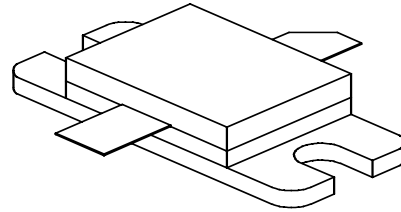
GENERAL DESCRIPTION

The 0910-150M is an internally matched, COMMON BASE transistor capable of providing 150 Watts of pulsed RF output power at 150 μ s pulse width, 5% duty factor across the band 890 to 1000 MHz. This hermetically solder-sealed transistor is specifically designed for P-Band radar applications. It utilizes gold metallization to provide high reliability.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Maximum Power Dissipation @ 25°C		400 Watts
Maximum Voltage and Current		
BVces	Collector to Emitter Voltage	65 Volts
BVebo	Emitter to Base Voltage	3.5 Volts
Ic	Collector Current	12 Amps
Maximum Temperatures		
Storage Temperature		- 65 to + 200°C
Operating Junction Temperature		+ 200°C

CASE OUTLINE 55KT, STYLE 1



ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25 °C

SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Pout	Power Out	Freq = 890 – 1000 MHz	150		210	Watts
Pg	Power Gain	Vcc = 48 Volts	8.1	8.5		dB
ηc	Collector Efficiency	Pin = 23 Watts	40	45		%
Pd	Pulse Droop				0.5	dB
RI	Input Return loss	Pulse Width = 150 μ s				dB
VSWR¹	Load Mismatch Tolerance	Duty Factor = 5%	-9		3:1	
VSWRs	Load Mismatch - Stability				2:1	

Note 1: Pulse condition of 150 μ sec, 5%.

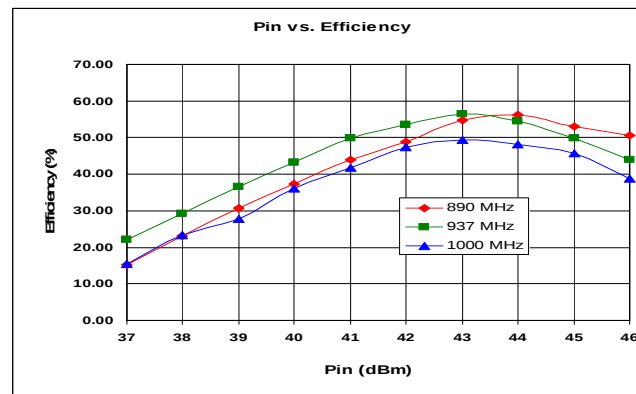
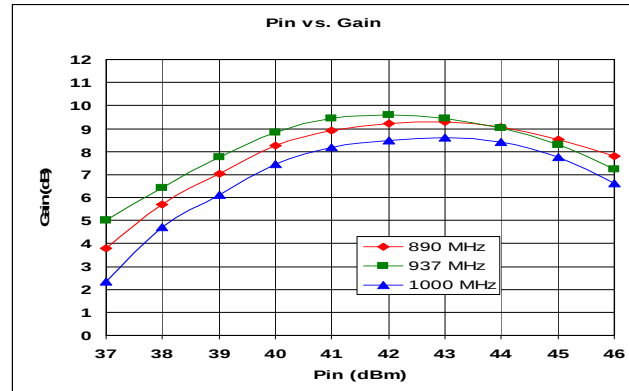
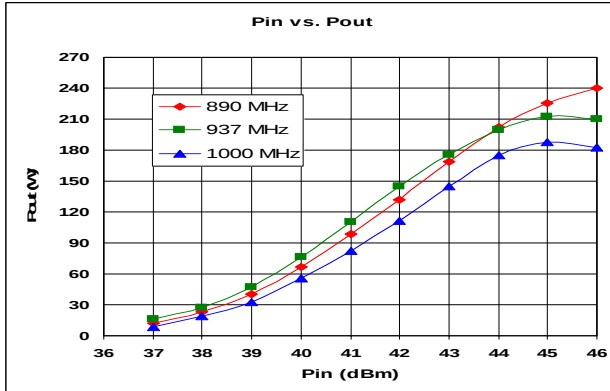
Bvces	Collector to Emitter Breakdown	Ic = 10 mA	65			Volts
Ices	Collector to Emitter Leakage	Vce = 50 Volts			10	mA
Iebo	Emitter to Base Leakage	Vebo = 2.5 Volts			5.0	mA
θjc¹	Thermal Resistance	Rated Pulse Condition			0.48	°C/W

Issue Mar 2005

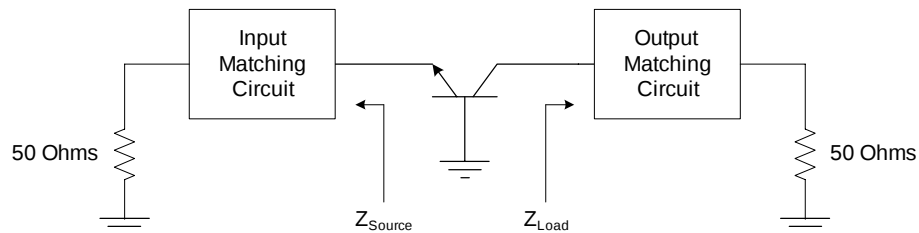


0910-150M

Performance Curves –



Impedance Information



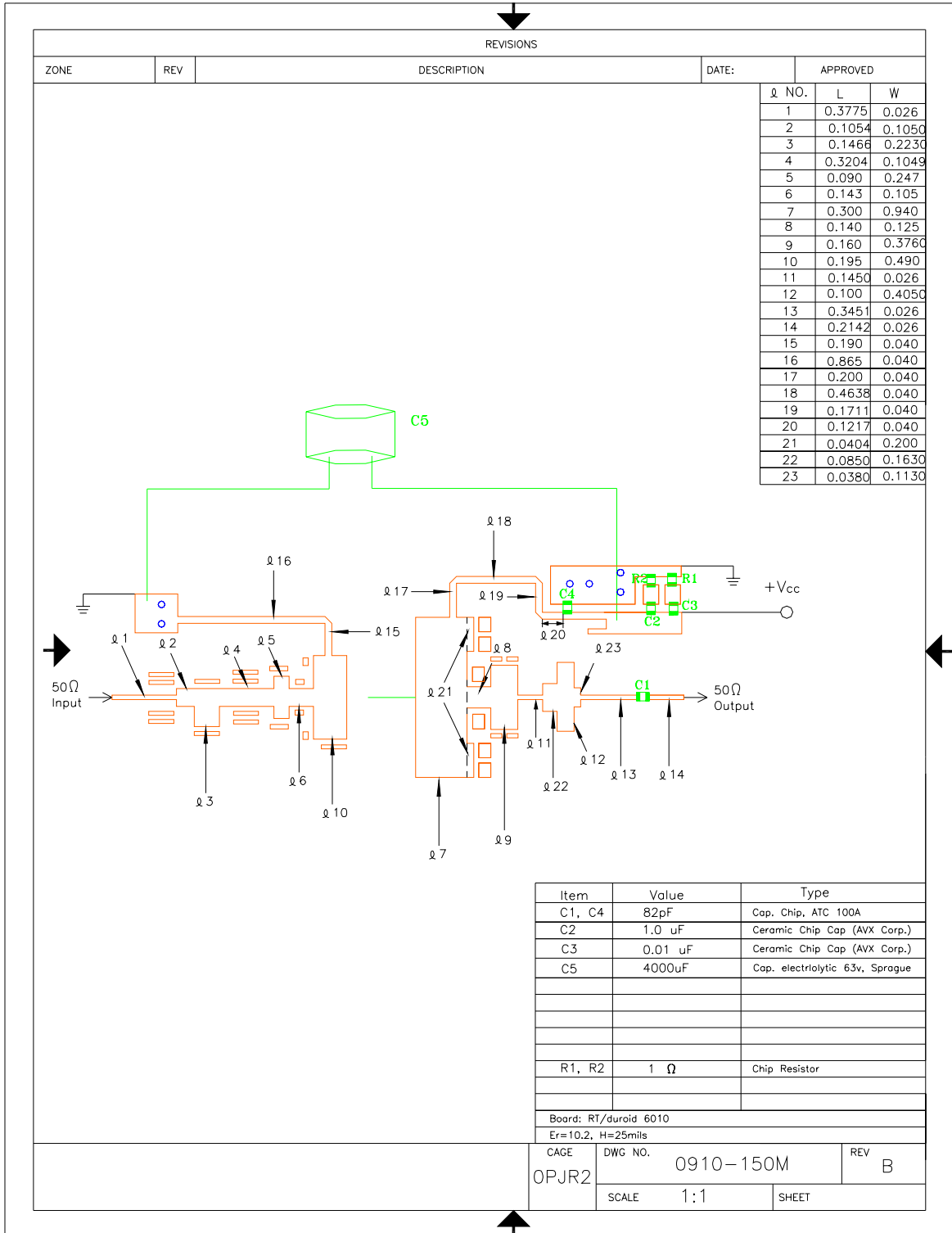
Frequencies (MHz)	$Z_{Source} (\Omega)$	$Z_{Load} (\Omega)^2$
890	4.0 - j4.2	1.85 - j3.2
937	4.0 - j3.5	1.97 - j3.0
1000	4.1 - j2.5	2.1 - j3.0

Note 2: Z_{Load} exclusive of C1 and C4 on the test circuit



0910-150M

Test Circuit

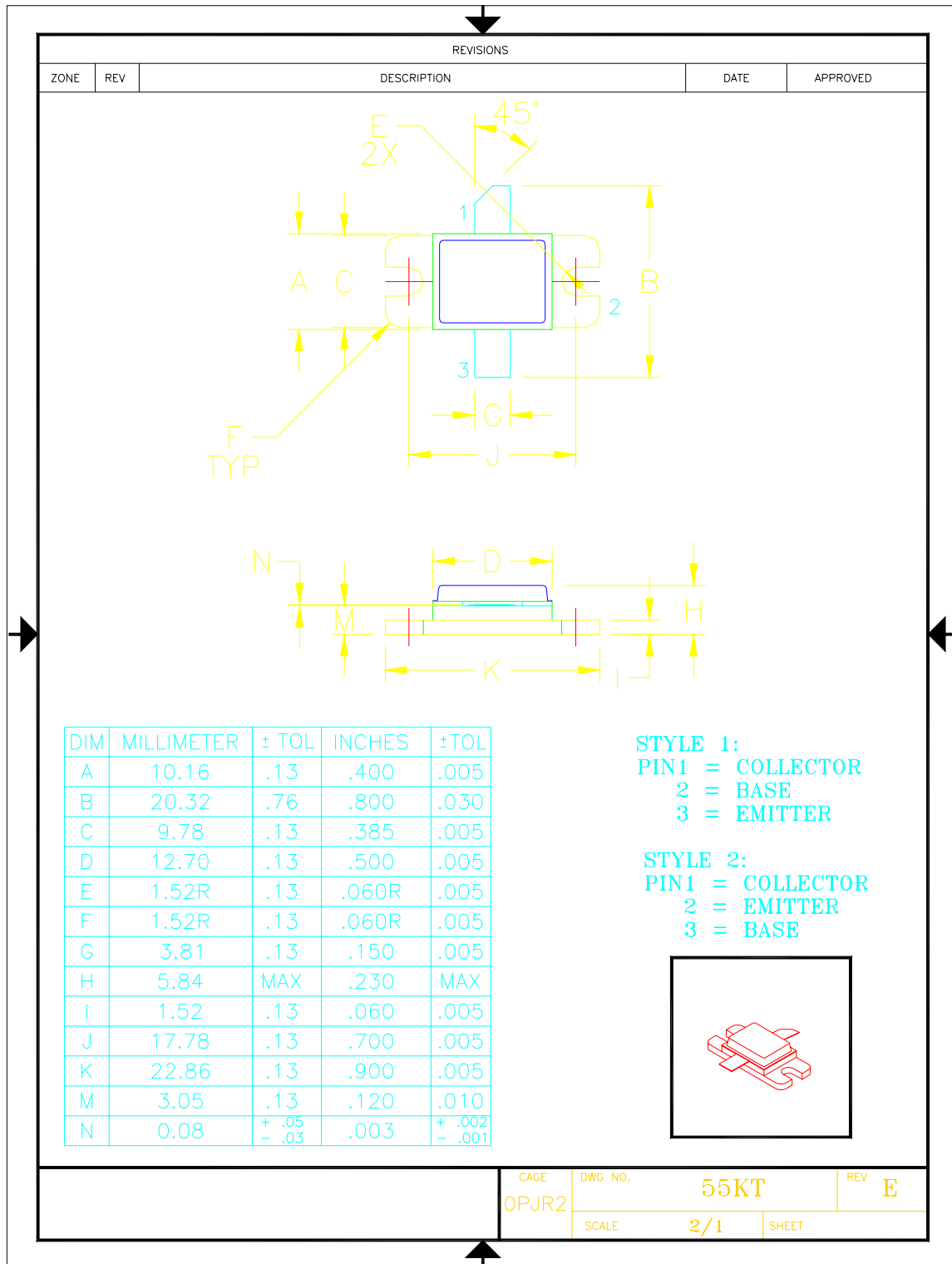


ADVANCED POWER TECHNOLOGY INC. RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE. TO VERIFY THE CURRENT VERSION PLEASE CHECK OUR WEB SITE AT WWW.ADVANCEDPOWER.COM OR CONTACT OUR FACTORY DIRECT.
Advanced Power Technology Inc. 3000 Oakmead Village Drive, Santa Clara, CA 95051-0808 Tel. 408 / 986-8031 Fax 408 / 869-2324



0910- 150M

Case Outline





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.